

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 6 部門第 2 区分
【発行日】 平成 16 年 11 月 11 日 (2004.11.11)

【公表番号】 特表 2000-503136 (P2000-503136A)

【公表日】 平成 12 年 3 月 14 日 (2000.3.14)

【出願番号】 特願 平 9-524976

【国際特許分類第 7 版】

G 0 3 F 7/40

G 0 2 B 3/00

H 0 1 L 21/3065

【F I】

G 0 3 F 7/40 5 2 1

G 0 2 B 3/00 A

H 0 1 L 21/302 J

【手続補正書】

【提出日】 平成 16 年 1 月 9 日 (2004.1.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 特許請求の範囲

【補正方法】 変更

【補正の内容】

手 続 補 正 書

16.1.-9

平成 年 月 日

特許庁長官 今 井 康 夫 殿



1.事件の表示 平成9年特許願第524976号

2.補正をする者

事件との関係 出 願 人

名 称 キネティック リミテッド

3.代 理 人

住 所 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
電話 (代) 3211-8741

氏 名 (5995) 弁理士 中 村 稔



4.補正命令の日付 自 発

5.補正対象書類名 明細書

6.補正対象項目名 請求の範囲

7.補正の内容 別紙記載の通り



方 式 査 査



請求の範囲

- (1) 基体上に三次元表面プロファイルを生産または変更する方法において、
 - (i) 基体のある領域がマスクによって保護され、ある領域が露出されるように上記基体上にレジストのマスクを形成するステップと、
 - (ii) 上記基体を複数の繰返しに曝すステップと、を備え、上記各繰返しは少なくとも1回のレジストエッチング及び少なくとも1回の基体エッチングからなり、適当なレジストエッチング用材料を使用して上記レジストエッチングを遂行して上記マスクの形状を、従って上記基体の露出される領域の形状を変更し、上記マスクによって上記基体を保護しながら適当な基体エッチング用材料を使用して上記基体エッチングを遂行して上記基体の露出された領域から材料を除去し、上記レジストエッチング及び上記基体エッチングは実質的に同時に行われないことを特徴とする方法。
- (2) 上記基体上に、光濃縮器が形成される請求項1に記載の方法。
- (3) 上記基体は、半導体材料からなる請求項1または2に記載の方法。
- (4) 上記基体は、InSbからなる請求項3に記載の方法。
- (5) 上記基体エッチング用材料は、 CH_4/H_2 プラズマからなる請求項4に記載の方法。
- (6) 上記レジストエッチング用材料は、酸素プラズマからなる請求項5に記載の方法。
- (7) InSbヘテロ構造材料内にウィンストンコーンエミッタが形成される請求項6に記載の方法。